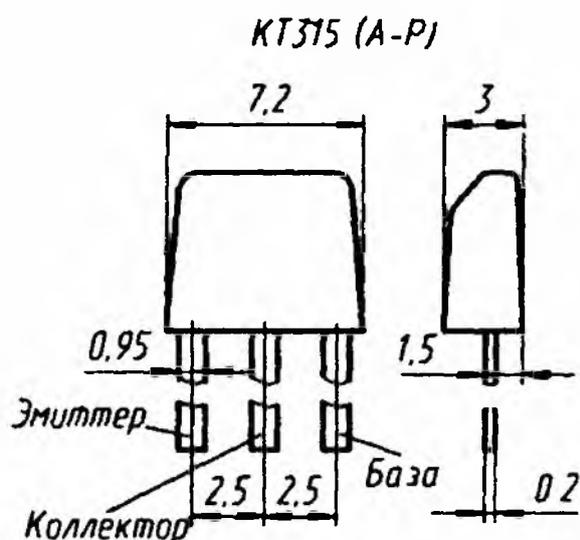


КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* уси-
лительные. Предназначены
для применения в усилите-
лях высокой, промежуточ-
ной и низкой частоты. Вы-
пускаются в пластмассовом
корпусе с гибкими вывода-
ми. Тип прибора указывает-
ся в этикетке, а также на
корпусе прибора в виде бук-
вы соответствующего типо-
номинала.

Масса транзистора не более 0,18 г.

Изготовители — акционерное общество «Кремний»,
г. Брянск, Нальчинский завод полупроводниковых приборов,
г. Нальчик, завод при НИИПП, г. Томск.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 1$ мА:

| | |
|------------------------------|-----------|
| КТ315А, КТ315В | 30...120 |
| КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е | 50...350 |
| КТ315Д..... | 20...90 |
| КТ315Ж..... | 30...250 |
| КТ315И, не менее | 30 |
| КТ315Р | 150...350 |

Граничная частота коэффициента передачи
тока при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 1$ мА, не менее.....

Постоянная времени цепи обратной связи
при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, не более:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| КТ315А | 300 пс |
| КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р | 500 пс |
| КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж..... | 1000 пс |
| КТ315И..... | 950 пс |

Граничное напряжение при $I_3 = 5$ мА,
не менее:

| | |
|------------------------------|------|
| КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж | 15 В |
| КТ315В, КТ315Д, КТ315И | 30 В |
| КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р..... | 25 В |

| | |
|---|----------|
| Напряжение насыщения коллектор—эмиттер | |
| при $I_K = 20$ мА, $I_E = 2$ мА, не более: | |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р | 0,4 В |
| КТ315Д, КТ315Е | 0,6 В |
| КТ315Ж..... | 0,5 В |
| КТ315И..... | 0,9 В |
| Напряжение насыщения база—эмиттер | |
| при $I_K = 20$ мА, $I_E = 2$ мА, не более: | |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р | 1 В |
| КТ315Д, КТ315Е | 1,1 В |
| КТ315Ж..... | 0,9 В |
| КТ315И..... | 1,3 В |
| Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В, | |
| не более..... | 1 мкА |
| Обратный ток коллектор—эмиттер | |
| при $R_{БЭ} = 10$ кОм, $U_{КЭ} = U_{КЭ, \text{МАКС}}$, не более: | |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, | |
| КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р | 1 мкА |
| КТ315Ж..... | 10 мкА |
| КТ315И..... | 100 мкА |
| Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В для | |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, | |
| КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р, не более.. | 50 мкА |
| Входное сопротивление при $U_{КЭ} = 10$ В, | |
| $I_K = 1$ мА, не менее | 40 Ом |
| Выходная проводимость при $U_{КЭ} = 10$ В, | |
| $I_K = 1$ мА, не более | 0,3 мкСм |
| Емкость коллекторного перехода | |
| при $U_{КБ} = 10$ В, не более: | |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, | |
| КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р | 7 пФ |
| КТ315Ж, КТ315И | 10 пФ |

Предельные эксплуатационные данные

| | |
|---|------|
| Постоянное напряжение коллектор—эмиттер | |
| при $R_{БЭ} = 10$ кОм: | |
| КТ315А | 25 В |
| КТ315Б, КТ315Ж | 20 В |
| КТ315В, КТ315Д | 40 В |
| КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р..... | 35 В |
| КТ315И..... | 60 В |
| Постоянное напряжение база—эмиттер..... | 6 В |
| Постоянный ток коллектора: | |
| КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, | |

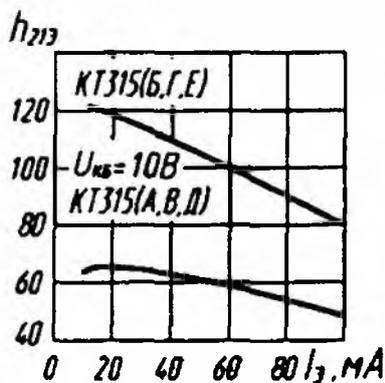
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р 100 мА
 КТ315Ж, КТ315И 50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T \leq +25 \text{ }^\circ\text{C}$:

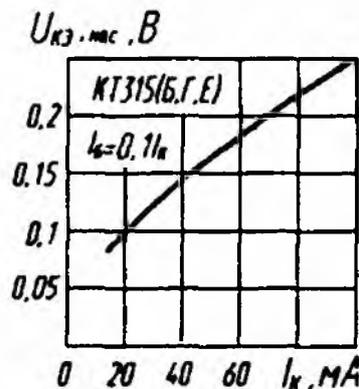
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,
 КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р 150 мВт
 КТ315Ж, КТ315И 100 мВт

Тепловое сопротивление переход—среда $0,67 \text{ }^\circ\text{C}/\text{мВт}$
 Температура р-п перехода $+120 \text{ }^\circ\text{C}$
 Температура окружающей среды $-60...+100 \text{ }^\circ\text{C}$

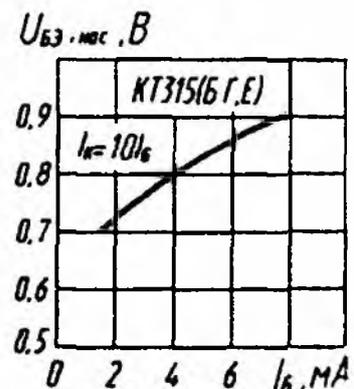
Допускается эксплуатация транзисторов в режиме $P_K = 250 \text{ мВт}$ при $U_{КБ} = 12,5 \text{ В}$, $I_K = 20 \text{ мА}$.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока базы